

**Modulbezeichnung:** Crystal Growth NT (CG) **15 ECTS**  
(Crystal Growth NT)

Modulverantwortliche/r: Peter Wellmann

Lehrende: Jochen Friedrich, Stefan Kasperl, Peter Wellmann

|                             |                        |                               |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Startsemester: WS 2013/2014 | Dauer: 2 Semester      | Turnus: halbjährlich (WS+SS)  |
| Präsenzzeit: 165 Std.       | Eigenstudium: 285 Std. | Sprache: Deutsch und Englisch |

**Lehrveranstaltungen:**

Praktikum Materialien der Elektronik und Energietechnik (WS 2013/2014, Praktikum, 3 SWS, Peter Wellmann)

Elektronische Bauelemente und Materialfragen (Technologie II) (SS 2014, Vorlesung, 2 SWS, Peter Wellmann)

Exkursionen (SS 2014, Exkursion, Peter Wellmann)

Grundlagen des Kristallwachstums und der Halbleitertechnologie (WS 2013/2014, Vorlesung, 2 SWS, Peter Wellmann)

**Wahlvorlesungen**

Bitte 5,5 ECTS wählen

Technologie der Züchtung von Halbleiterkristallen und Photovoltaik (SS 2014, optional, Vorlesung, 2 SWS, Jochen Friedrich)

Halbleiter großer Bandlücke (SS 2014, optional, Vorlesung, 1 SWS, Peter Wellmann)

Aufbau- und Verbindungstechnik in der Leistungselektronik (WS 2013/2014, optional, Vorlesung, 2 SWS, Uwe Scheuermann)

Physikalische Grundlagen und Anwendungen der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung (WS 2013/2014, optional, Vorlesung, 2 SWS, Stefan Kasperl)

**Empfohlene Voraussetzungen:**

Bachelor in Materialwissenschaften, Nanotechnologie, Energietechnik, Elektrotechnik, Physik, Chemie oder in einem vergleichbaren Studiengang

**Inhalt:**

Grundlagen des Kristallwachstums und der Halbleitertechnologie

- Grundlagen des Kristallwachstums
- Grundlagen der Silizium Halbleitertechnologie (Oxidation, Dotierung mittels Diffusion und Ionenimplantation, Ätzen, Metallisierung, Lithografie, Packaging)

Elektronische Bauelemente und Materialfragen

- Korrelation von Bauelementfunktion (Bipola-Diode, Bipolar-Transistor, Schottky-Diode, Feldeffekt-Transistor, Leucht- und Laserdiode) Mit Materialeigenschaften

- Grundlagen der Epitaxie

Kristallwachstum - Ausgewählte Kapitel

- Modellierung in der Kristallzüchtung
- Ausgewählte Kapitel
- Kristallwachstum für solare Anwendungen

Praktikum

- Czochralski Kristallwachstum von InSb
- Modellierung in der Kristallzüchtung
- Halbleitercharakterisierung

**Lernziele und Kompetenzen:**

- Die Studierenden erwerben fundierte Kenntnisse über Materialeigenschaften und deren Anwendung in elektronischen Bauelementen.
- Kennenlernen experimenteller Techniken in den Werkstoffwissenschaften, Verfassen von technischen Berichten, Teamarbeit

**Literatur:**

Wird in den Lehrveranstaltungen angegeben.

---

**Studien-/Prüfungsleistungen:**

Crystal Growth NT (Prüfungsnummer: 688067)

(englische Bezeichnung: Crystal Growth NT)

Prüfungsleistung, mündliche Prüfung, Dauer (in Minuten): 30

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100%

Erstabwegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014

1. Prüfer: Peter Wellmann

---